

а 2004 0096

Изобретение относится к оптоэлектронике, и в частности к линзам с градиентом коэффициента преломления. Сущность изобретения заключается в том, что в полупроводниковую подложку имплантируют ионы с дозой высокой энергии, определяемой соотношением

$$D=\alpha R^2,$$

где

D – доза высокой энергии имплантируемых ионов,

R – расстояние от центра до периферии подложки,

α – градиент дозы,

а затем осуществляют электрохимическое травление.

П. формулы: 1

Фиг.: 1